

## 产品特点

高精度胶片处理技术  
高性能, 低温漂, 大功率  
陶瓷基板, 50Ω共面波导  
金丝键合, 适用于多芯片集成模块

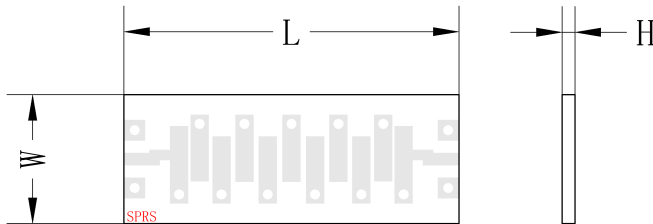
## 技术要求

| 项目    | 参数             | 单位  |
|-------|----------------|-----|
| 中心频率  | 8.8            | GHz |
| 工作带宽  | 8.7-8.9        | GHz |
| 中心损耗  | 5.2            | dB  |
| 带内波动  | 1.0            | dB  |
| 驻波比   | 1.7:1          |     |
| 群时延波动 | 0.5            | ns  |
| 带外抑制  | 40@DC-7.9GHz   | dBc |
| 带外抑制  | 40@9.5-21.0GHz | dBc |

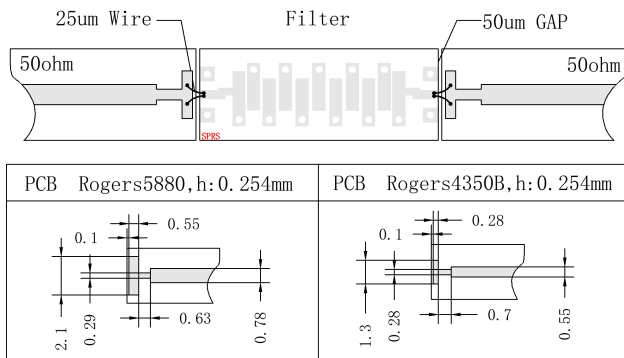
## 其它要求：设计保证

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 承受功率 | 2W CW                        |
| 工作温度 | -55 ~ +85°C                  |
| 储存温度 | -55 ~ +125°C                 |
| 外形尺寸 | L : 9.0 , W : 4.5 , h : 0.26 |

## 外形图：端口居中



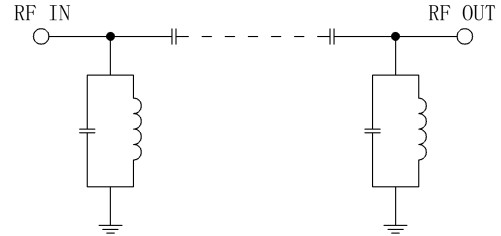
## 推荐装配图



## 注意事项

- 1: 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖2.75mm, 端口可互换;
- 2: 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
- 3: 芯片应安装在可伐 (推荐) 或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C), 载体厚度 ≥ 0.2mm;
- 4: 微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

## 原理图



## 典型曲线

